



Наука в Сибири

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

27 октября 2011 года • 51-й год издания • № 43 (2828) • <http://www.sbras.ru/HBC/> • Цена 7 руб.

НОВОСТИ

Финансирование фундаментальной науки остается приоритетом

Приоритетом для российских властей остается вкладывание средств в фундаментальные научные исследования и модернизация университетов, научно-исследовательских центров, лабораторий, заявил в ходе пленарного заседания международного форума RUSNANOTECH-2011 Президент России Дмитрий Медведев: «Очевидно, что расширение программы финансирования фундаментальных исследований для нас остается абсолютным приоритетом, мы вкладываем значительные средства в оснащение современным оборудованием университетов, научно-исследовательских центров, лабораторий, стимулируем создание новых программ. На эти цели в перспективной программе до 2014 года заложено почти 8 млрд долларов».

Награды Родины

Указом Президента Российской Федерации за большие заслуги в области науки и многолетнюю плодотворную деятельность награждена большая группа ученых, среди которых сибиряки, награжденные медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: В.Г. Абрамов, главный инженер проекта «Комплекс» ИСЗФ СО РАН; В.Н. Захаров, главный научный сотрудник ИЛФ СО РАН, чл.-корр. РАН А.В. Каныгин, главный научный сотрудник ИНГ СО РАН; В.И. Скоморовский, зав. лабораторией ИСЗФ СО РАН.

Сибирские учёные — иностранные члены АНМ

22 октября в Улан-Баторе президент Академии наук Монголии Б. Энхтувшин вручил дипломы и мантии иностранных членов АНМ председателю Сибирского отделения академику А.Л. Асееву и председателю Президиума Бурятского научного центра СО РАН чл.-корр. РАН Б.В. Базарову. Почётного звания удостоен также академик М.И. Кузьмин, который не смог приехать в столицу МНР, и соответствующие регалии будут вручены ему позже.

В Томске подвели итоги форума

В Национальном исследовательском Томском политехническом университете завершился работу форум «Перспективные технологии XXI века — Россия и зарубежье», на котором велось обсуждение исследовательских проектов, реализуемых в российских вузах под руководством ведущих зарубежных ученых. Главной целью прошедшего под эгидой Министерства образования и науки РФ форума стала выработка критериев оценки вклада российских вузов и сотрудничающих с ними ведущих зарубежных ученых в реализацию постановления № 220 (о мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования). К работе в России уже приступили 78 зарубежных ученых-победителей двух конкурсов на право получения мега-гранта. На реализацию проекта уже потрачено 8 млрд рублей, а в 2012 году будет выделено ещё 4 миллиарда.

30 лет — это возраст свершений

В октябре исполнилось 30 лет со дня образования Специального конструкторского бюро вычислительной техники СО АН СССР, преобразованного в 1990 году по инициативе Валентина Афанасьевича Коптюга в Конструкторско-технологический институт вычислительной техники.



В июне 2010 года КТИ ВТ возглавил доктор физико-математических наук Сергей Кузьмич Голушко. Год назад в рубрике «Институт крупным планом (см. «НВС» № 48 от 02.12.2010 г., «КТИ ВТ: выбор направления») мы уже обсуждали с Сергеем Кузьмичём те вызовы и новые задачи, которые ставит время

перед институтом. Юбилей института — хороший повод продолжить разговор.

Продолжение темы см на стр. 4—5.

На снимке В. Новикова:

— коллектив КТИ ВТ в преддверии празднования своего 30-летия.

Форум по нанотехнологиям

В Москве начал работу 4-й международный форум по нанотехнологиям Rusnanotech-2011, в научной и конкурсной программах которого принимают широкое участие представители Сибирского отделения РАН.

Заместитель председателя Правительства России С.Б. Иванов, открывая форум в качестве председателя его оргкомитета, отметил происшедшие перемены: «Четыре года назад в этом зале мы впервые на российской площадке заявили о необходимости построения новой отрасли экономики — наноиндустрии. Сегодня мы уже можем подвести промежуточные итоги. Очевидно, что в России возможны механизмы эффективного отбора и становления проектов в сфере высоких технологий». Заместитель главы правительства сообщил, что сегодня в наноиндустрии занято около 150 тыс. человек. К 2015 году по линии «РОСНАНО» планируется достичь выпуска продукции на сумму не менее 300 миллиардов рублей, а в целом по отрасли — выйти на объём порядка 900 миллиардов.

Председатель правления «Роснано» А.Б. Чубайс выступил с позиций глобального анализа. По его мнению, минувшее столетие привело «к перелому всех трендов и нарастающему конфликту человечества и природы». На текущей неделе на Земле должен родиться семимиллиардный житель, и, по мнению А.Б. Чубайса, с учётом нарастающего прироста населения, «единственным трендом на XXI век остаётся сбалансированное устойчивое развитие». «Нужно понять, как это может происходить, — сказал он. — По моему мнению, требуется решение целого ряда прорывных фундаментальных проблем».

Назвав свою точку зрения «позицией меньшинства», Анатолий Борисович заявил, что Россия готова представить свои ответы на глобальные

вызовы. Глава «Роснано» перечислил в этом контексте ряд направлений, в том числе создание новых строительных и конструкционных материалов, наноэлектронику и наноплатонику, «новую энергетику» и «новую медицину», также базирующиеся на наноматериалах и нанотехнологиях. При этом А.Б. Чубайс считает, что «ни один из наших проектов не смог бы существовать, если за ним не стоит наука, не стоит образование».

В качестве примера он привёл «отраслевой прорыв» — создание литий-ионных аккумуляторов нового поколения и начало с 2012 года их промышленного выпуска на крупнейшем в Евразии предприятии «Лиотех» (на площадке и при содействии Новосибирского завода химконцентратов и на основе технологии, принципы которой разработаны в Институте химии твёрдого тела и механохимии — А.С.).

После панельной дискуссии на тему «Спрос на инновации» на форуме открывается работа научных секций, одной из которых — «Нанозлектроника и наноплатоника» — руководят вице-президент РАН, председатель СО РАН ак. А.Л. Асеев, директор Физико-технологического института РАН ак. А.А. Орликовский, директор Института лазерной физики СО РАН академик С.Н. Багаев, заместитель директора Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН чл.-корр. РАН А.В. Двуреченский, заместитель директора Института проблем химической физики РАН чл.-корр. РАН В.Ф. Разумов и профессор Ю.Цзиньжун из Института полупроводников Китайской академии наук.

А. Соболевский, ЦОС СО РАН